(上接 C24 版)

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(中期现金分红无需审计)。

3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的 50%且超过 5000 万元人民币。

(四)现金分红的比例和间隔：

公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的 50%且超过 5000 万元人民币。

(五)发放股票股利的条件

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

(六)利润分配的决策机制和程序

1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(七)利润分配政策调整的决策机制与程序

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并分别经监事会和二分之一以上独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体董事的二分之一以上同意。”

(六)公司控股子公司、参股子公司基本情况

截至本招股书签署日，公司拥有新洁能香港、电基集成 2 家全资子公司以及新洁能深圳分公司、新洁能宁波分公司 2 家分公司，无参股子公司。具体情况如下：

1、新洁能香港

公司名称	新洁能功率半导体（香港）有限公司	成立时间	2010年 7 月 6 日
注册资本	51.00 万美元	实收资本	6.10 万美元
注册地址	香港皇后大道中 181 号新纪元广场（低座）1501 室		
经营范围	电力电子元器件的研发、生产、销售；集成电路的研发、销售和贸易		
股东构成	股东名称	股权比例	
	新洁能	100.00%	
	合计	100.00%	
主要财务数据（万元）（已经申报会计师审计）	2019年 12 月 31 日	2018年 12 月 31 日	
	总资产 61.97	总资产 62.27	
	净资产 61.97	净资产 62.27	
	2019年度	2018年度	
	净利润 -0.30	净利润 5.52	

2、电基集成

公司名称	无锡电基集成科技有限公司	成立时间	2017年 3 月 21 日
注册资本	12,000.00 万元	实收资本	12,000.00 万元
注册地址	无锡市新吴区研发二路以南、研发一路以东		
经营范围	电子元器件、电力电子元器件及半导体模块产品及其它电子产品的设计、制造、销售；集成电路及其它电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、制造、销售；计算机软件的研发、技术转让；环境保护专用设备的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
股东构成	股东名称	股权比例	
	新洁能	100.00%	
	合计	100.00%	
主要财务数据（万元）（已经申报会计师审计）	2019年 12 月 31 日	2018年 12 月 31 日	
	总资产 13,157.51	总资产 13,368.84	
	净资产 11,762.76	净资产 11,946.87	
	2019年度	2018年度	
	净利润 -184.11	净利润 -44.70	

3、新洁能深圳分公司

公司名称	无锡新洁能股份有限公司深圳分公司	成立时间	2013年 12 月 4 日
统一社会信用代码	914403000846106229		
营业场所	深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前进二路交汇处美兰商务中心 802		
经营范围	电力电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软件的研发、技术转让；利用自有资产对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。环境保护专用设备的制造、销售。		

4、新洁能宁波分公司

公司名称	无锡新洁能股份有限公司宁波分公司	成立时间	2019年 10 月 10 日
统一社会信用代码	91330212MA2GU7ACX6		
营业场所	浙江省宁波市鄞州区实怡中心 8 幢 26 号 10-6		
经营范围	电力电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软件的研发、技术转让；环境保护专用设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

第四节 募集资金运用

根据 2018 年 11 月 19 日通过的 2018 年第三次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公开发行人民币普通股 A 股，发行数量为不超过 2,530.00 万股。募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定。根据股东大会的授权，2020 年 6 月 2 日经公司第三届董事会第八次会议及 2020 年 7 月 31 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，对本次投资项目的募集资金使用金额进行调整。

本次发行 A 股募集资金计划全部用于以下与主营业务相关的项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化	48,118.04	20,000.00
2	半导体功率器件封装测试生产线建设	32,014.90	20,000.00
3	碳化硅宽禁带半导体功率器件研发及产业化	11,419.27	-
4	研发中心建设	5,501.86	4,898.80
5	补充流动资金	5,000.00	-
合 计		102,054.07	44,898.80

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金，先行投入。本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于投资项目资金需求量，公司将通过银行贷款和其他自筹资金解决。

一、超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化项目

本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。项目旨在对公司现有产品升级换代，开发新一代超低能耗高可靠性半导体功率器件，突破超低能耗功率器件设计技术门槛，打破国外产品在高端应用领域的垄断地位。

本项目总投资额为 48,118.04 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占比	第一年	第二年	第三年
1	固定资产投资	6,094.60	12.67%	3,689.40	2,405.20	-
1.1	设备投资	5,764.60	11.98%	3,359.40	2,405.20	-
1.2	土建投资	330.00	0.69%	330.00	-	-
2	研发费用	33,782.29	70.21%	7,067.47	11,353.53	15,361.29
2.1	开发费用	1,182.00	2.46%	198.00	442.00	542.00
2.2	试制费用	25,486.30	52.97%	5,394.91	8,548.49	11,542.90
2.3	封装测试费用	6,763.99	14.06%	1,424.56	2,263.03	3,076.39
2.4	IP core	350.00	0.73%	50.00	100.00	200.00
3	软件投资	1,120.00	2.33%	1,120.00		
4	铺底流动资金	7,121.15	14.80%	2,373.72	2,373.72	2,373.72
合 计		48,118.04	100.00%	14,250.59	16,132.44	17,735.01

项目建设期为 36 个月，运营期为 T+1 期至 T+10 期。根据规划，项目建成后，运营期 T+1 期部分开发产品陆续正式投产，T+1 期达到设计产能的 40%，T+2 期产能达到 80%，T+3 期完全达产。根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：

指标名称	指标值	
年平均销售收入（万元）	83,144.45	
年平均利润总额（万元）	7,491.05	
年平均上缴所得税（万元）	1,123.66	
年平均税后利润（万元）	6,367.39	
年总投资收益率	15.57%	
	所得税前	所得税后
内部收益率	24.15%	21.19%
财务净现值（ic=10%）（万元）	24,729.48	18,920.37
投资回收期（含建设期）	5.74	6.15

二、半导体功率器件封装测试生产线建设项目

本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。主要建设内容包括：针对公司现有的封装形式（DPAK/SOT/TO）进行产业链延伸；TO-247/TO-3P IGBT 及大功率 MOSFET 芯片封装；低热阻 SOP-8 封装的产业化；基于 Cu-Clip 工艺技术，实现高功率密度低功耗器件封装；芯片封装集成器件及大功率模块的研发和封装产业化。

本项目总投资额为 32,014.90 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占比	第一年	第二年
1	固定资产投资	29,319.40	91.58%	20,671.40	8,648.00
1.1	设备投资	25,482.00	79.59%	16,834.00	8,648.00
1.2	土建投资	3,837.40	11.99%	3,837.40	-
2	软件投资	255.00	0.80%	-	255.00
3	铺底流动资金	2,440.50	7.62%	1,220.25	1,220.25
合 计		32,014.90	100.00%	21,891.65	10,123.25

项目建设期为 18 个月，运营期为 T+1 期至 T+10 期。运营期 T+1 期公司开始正式投产，产能利用率为 40%，T+2 期为 80%，T+3 到 T+10 期 100%完全达产。根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：

指标名称	指标值	
年平均销售收入（万元）	28,494.62	
年平均利润总额（万元）	5,107.24	
年平均上缴所得税（万元）	1,276.81	
年平均税后利润（万元）	3,830.42	
年总投资收益率	15.95%	
	所得税前	所得税后
内部收益率	16.52%	12.45%
财务净现值（ic=10%）（万元）	10,670.81	3,893.75
投资回收期（含建设期）	6.61	7.61

三、碳化硅宽禁带半导体功率器件研发及产业化项目

本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。本项目是基于宽禁带半导体碳化硅材料的功率器件研发及产业化，包括 SiC SBD（肖特基二极管）及 SiC MOSFET 两类产品。本项目的实施旨在突破高压 SiC 功率器件关键技术，重点针对碳化硅二极管浪涌电流能力提升技术、碳化硅二极管雪崩耐量提升技术、沟槽底部氧化层峰值电场抑制技术、器件终端边缘电场疏导技术进行研发。开发碳化硅功率器件，打破国外产品在碳化硅宽禁带半导体功率器件技术垄断，实现我国碳化硅功率器件的国产化。

本项目总投资额为 11,419.27 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占比	第一年	第二年	第三年
1	固定资产投资	767.75	6.72%	426.65	341.10	-
1.1	设备投资	497.75	4.36%	156.65	341.10	-
1.2	土建投资	270.00	2.36%	270.00	-	-
2	研发费用	9,561.85	83.73%	1,667.62	2,850.19	5,044.04
2.1	开发费用	848.00	7.43%	224.00	312.00	312.00
2.2	试制费用	8,158.19	71.44%	1,345.55	2,374.71	4,437.93
2.3	封装测试费用	355.67	3.11%	58.07	103.48	194.11
2.4	IP core	200.00	1.75%	40.00	60.00	100.00
3	软件投资	280.00	2.45%	280.00	-	-
4	铺底流动资金	809.67	7.09%	269.89	269.89	269.89
合计		11,419.27	100.00%	2,644.16	3,461.18	5,313.93

项目建设期为 36 个月，即为 T+1 期至 T+3 期。根据规划，项目建设期公司将完成 SiC SBD 及 SiC MOSFET 系列产品的研发。同时，T+1 期部分开发产品陆续正式投产，T+1 期达到设计产能的 40%，T+2 期产能达到 80%，T+3 期完全达产。根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相符的前提下，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：

指标名称	指标值	
年平均销售收入（万元）	9,541.13	
年平均利润总额（万元）	855.04	
年平均上缴所得税（万元）	128.26	
年平均税后利润（万元）	726.78	
年总投资收益率	7.49%	
	所得税前	所得税后
内部收益率	16.64%	14.74%
财务净现值（ic=10%）（万元）	1,901.29	1,304.56
投资回收期（含建设期）	7.06	7.36

四、研发中心建设项目

本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。项目旨在完善和加强公司在半导体功率器件领域的综合技术研发能力与项目产业化能力，依托公司研发中心，充分调动产业链核心技术资源，创新开发功率器件领域的新技术、新产品，打破国际大厂在高端功率器件上的长期垄断地位。研发中心计划开展的主要研发项目有：高能效高可靠性电机驱动系统中功率器件的研发与产业化、低能耗大功率 MOSFET 模块的研发及功率器件综合实验室的升级。

项目总投资为 5,501.86 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	占比	第一年
1	固定资产投资	5,335.86	96.98%	5,335.86
1.1	设备投资	4,870.86	88.53%	4,870.86
1.2	土建投资	465.00	8.45%	465.00
2	软件投资	166.00	3.02%	166.00
合 计		5,501.86	100.00%	5,501.86

本项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但研发中心的建设将提升公司整体研发实力、提高核心竞争力，研发实力的提升可增强客户对公司的信任度，进一步强化公司的品牌优势，扩大市场份额，实现公司长远的战略目标。

五、补充流动资金项目

报告期内，公司发展迅速，经营规模呈现快速增长趋势。2016 年至 2018 年，公司分别实现营业收入 42,211.51 万元、50,375.98 万元和 71,579.03 万元，年复合增长率达到 30.22%。在国家半导体产业政策大力支持以及下游市场需求持续增长的背景下，预计未来公司经营规模仍将保持快速增长的趋势。公司资产主要以流动资产为主，公司日常经营较多涉及现款支付，折旧、摊销类的非现金支出相对较少。因此，公司需要保持较高水平的流动资金用于新产品技术研发、人才引进、原材料采购、市场销售等环节，以保持公司的竞争优势和行业领先地位，推动公司业务可持续发展。

通过补充流动资金，公司可进一步优化财务结构，防范经营风险，保证公司业务的顺利开展，有利于公司扩大业务规模，提高公司的综合竞争力，为公司未来可持续发展创造宽松的资金环境和良好的融资条件。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

(一)市场风险

1、市场波动风险

半导体分立器件作为基础性电子元器件，为国民经济的多个领域所必不可缺，因此半导体分立器件行业的下游分布极为广泛。广泛的下游应用领域提升了公司应对单一市场波动风险的能力，但半导体分立器件行业与宏观经济的整体发展的景气程度密切相关，国内经济整体增速放缓及中美贸易摩擦等因素通过对下游行业的生产经营产生不利影响进而传导至半导体分立器件行业。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体分立器件行业的市场需求也将随之受到影响；下游行业的波动和低迷会导致对半导体分立器件的需求下降、价格敏感性提高。虽然近几年全球半导体分立器件市场保持稳步增长，且亚洲地区特别是中国市场规模增幅巨大，但是如果由于中美贸易摩擦等因素引致下游市场整体持续波动、全球经济或国内经济发生重大不利变化，将对半导体分立器件行业及公司等行业内企业的经营业绩造成不利影响。

2、行业竞争风险

近年来随着我国消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的蓬勃发展以及新能源汽车 / 充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等新兴领域凸起，国内对半导体分立器件的需求迅速扩大，直接拉动了行业的快速发展，也吸引了国内外企业进入到行业内，市场竞争日趋激烈。一方面，国内半导体分立器件企业不断增加，且部分企业不断通过技术升级等措施提高竞争力；另一方面，国外优秀的半导体分立器件企业进入国内抢占市场份额。在日趋激烈的市场竞争环境下，如果公司不能持续进行技术升级、提高产品性能、降低产品成本以及优化营销网络，则很可能在未来的市场竞争中丧失优势，从而对公司持续盈利造成不利影响。

3、产品替代风险

半导体分立器件行业属于技术密集型行业，具有技术和产品更新换代速度较快的特点。半导体分立器件下游应用领域日新月异，产品的形态、功能以及差异化需求在短时间内都可能发生很大变化，这都导致半导体分立器件产品生命周期越来越短，替代现象日趋显现。未来，随着新材料的应用和新技术的不断突破，在满足经济性条件下，新一代的半导体分立器件产品将可能出现，并对现有的产品形成一定冲击。如果公司不能持续紧跟行业发展前沿并进行技术升级换代、研发适应行业和市场的产品，则公司存在产品被替代的风险，从而失去持续经营能力。

4、采购价格波动风险

芯片代工和封测服务为公司主要的采购内容，占产品成本的比重较大。芯片代工和封测服务价格的波动将对公司的经营业绩产生一定影响。芯片代工价格一方面受到硅晶圆材料价格和制造成本、人工成本影响，另一方面则受到芯片代工企业投资规模和产能影响；封测服务价格受到原材料价格和人工成本等影响。报告期内，公司与国内主要的芯片代工企业和封装测试企业建立了较为紧密的合作关系，对其采购价格在一定区间内合理波动，且公司亦能够通过适度调整产品结构和价格、产品技术升级等方式进行应对。但是，如果芯片代工和封测服务的市场价格持续大幅上涨、而公司无法采取有力措施进行应对，则将对公司盈利能力造成不利影响。

(二)运营风险

1、供应商依赖的风险

公司是半导体专业化垂直分工企业，芯片代工及封装测试环节主要通过向供应商采购。公司拥有涵盖了华虹宏力、华润上华、中芯集成等国内少数几家具备 MOSFET、IGBT 等 8 英寸半导体芯片代工能力的本土芯片代工供应商，并不断拓展韩国等地区的芯片代工供应渠道。而在封装测试环节，公司主要与长电科技（600584）、安靠技术（Amkor）、通富微电（002156）等全球领先的封装测试企业合作，一定程度上也保证了公司产品的领先性。由于半导体行业垂直分工的特殊性，专注于芯片设计环节的企业在选择供应商后一般不会轻易更换；同样，芯片代工及封装测试企业如若更换客户则需重新调整产线、设备技术参数、产能排期等，这将形成较大的更换成本。因此，双方在一定程度上相互依赖。如果公司主要供应商产能严重紧张或者双方关系恶化，则可能导致公司产品无法及时、足量供应，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

2、供应链管理不善风险

半导体分立器件行业高度分工协作，产业链包括芯片设计、芯片制造、封装测试、对外销售等环节，各个环节相互依存、高度相关。行业内企业根据分工不同采用垂直一体化或垂直分工模式，其中部分垂直分工模式的企业主要负责芯片设计研发和销售环节，而将芯片制造、封装测试环节主要委托给专业代工厂商完成，因此，其产品质量、交货时间、生产能力等都与产业链其他环节紧密相关。公司为专业化垂直分工企业，与行业内优秀的芯片制造和封装测试厂商建立了长期、稳定的合作关系。公司建成封装测试产线，实现少部分功率器件的自主生产，公司不断加强生产环节的质量、成本管控，保障产品的品质。但是，如果公司对供应链及生产环节管理不善，导致产品质量、交付及时性等出现问题，则会影响公司产品销售和品牌声誉，对公司的经营造成不利影响。

3、新产品开发风险

公司销售的产品按照是否封装可以分为芯片和功率器件，按照功能分类已形成沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）以及功率模块等多品类产品系列，且 MOSFET 等产品系列较为全面。公司在现有产品的基础上，仍紧跟半导体分立器件行业发展前沿，以国际一流企业的最新技术和产品为标杆，以下游市场需求为导向，不断进行新产品的开发。但是，半导体功率器件新产品的研发往往需要一定的时间周期，需要投入较多的人力成本和资金成本，且面临较大的失败风险，或者开发的新产品尚不具备商业价值，可能导致前期的各项成本投入无法收回，从而影响公司经营业绩。

4、产品质量控制风险

半导体分立器件属于基础性电子元器件，为下游产品的核心部件之一。半导体分立器件的下游产品对性能要求严格，电子元器件质量出现问题将对下游客户的销售和品牌产生不利影响。因此，半导体分立器件下游行业对器件的质量非常重视，往往在采购前和合作过程中均需反复验证和测试。公司始终将产品质量控制作为持续发展的重要基础之一，建立了较为健全的质量控制体系，并在各个环节严格把控，产品质量整体保持稳定。但是，半导体分立器件技术和工艺复杂，在不同环节很可能由于多种因素导致产品质量不佳或性能下降，从而导致质量纠纷，影响公司的市场地位和品牌影响力。

5、经营模式风险

公司主要采用 Fabless 经营模式，专注于 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售环节，芯片主要由公司设计方案后交由芯片代工企业进行生产，功率器件主要由公司委托外部封装测试企业对芯片进行封测代工而成，尽管公司已初步完成先进封装测试生产线的建设，将少部分芯片自主封装后对外销售。由于公司本身不具备芯片制造能力以及封装测试生产线规模相对较小，芯片制造、封装测试环节仍需依托芯片代工企业和外部封装测试企业。为保证公司产品供应环节的稳定，公司已与多家具有雄厚实力的芯片代工企业和封装测试企业建立了长期稳定的合作关系。但在半导体分立器件行业生产旺季，可能会存在芯片代工企业和封装测试企业产能不足，不能完全保证公司产品及时供应的风险。

(三)技术风险

1、技术升级的风险

半导体分立器件行业为技术密集型行业，行业竞争的关键在于新技术、新产品的竞争。新技术、新产品的研发及产业化应用周期长、投入大，且新产品量产后，还面临着产品更新换代速度快、产品不能满足市场需求变化的风险。公司拥有高素质的技术研发团队，并与科研院所在半导体功率器件设计领域开展长期合作。公司还成立了技术研发小组专门从事新技术和新产品的研发，并依据行业技术发展趋势、市场动态以及客户需求确定公司的研发规划和具体措施。但是，如果公司的新技术、新工艺的研发未能持续升级换代，新产品的产业化未能保持市场领先地位，将会对公司的市场竞争和经营产生不利的影响。

2、技术人才流失风险

研发设计能力是半导体分立器件企业竞争力的核心之一，其主要来源于企业的研发技术人才，因此半导体分立器件产业的快速发展对专业技术人才产生了巨大的需求。公司在产品技术升级、新产品推出、产品的售后服务等方面高度依赖于公司的研发团队。自成立以来，公司已培养和引进了一批高素质研发人才，并通过实施股权激励、签订保密协议等多项激励和约束机制，以维系研发团队稳定。但是，如果公司核心研发人员大量流失，公司的研发能力、新产品开发及持续盈利能力将受到一定的影响，并可能给公司带来新的竞争对手。

(四)财务风险

1、毛利率下降的风险

2017 年至 2019 年，公司综合毛利率分别为 24.69%、31.63%和 20.73%。2017 年至 2018 年，受益于下游市场需求的持续增长，积极拓展毛利率较高的下游应用行业，大力开发新产品和新技术，积极开拓龙头客户从而提升公司品牌影响力和市场美誉度，公司综合毛利率保持稳定上升的趋势。2019 年，受中美贸易摩擦及国内市场竞争有所加剧等因素影响，公司芯片和功率器件毛利率有所下降。半导体分立器件企业的经营业绩受产品技术水平、市场竞争情况、下游市场需求等因素影响较大，如果未来公司产品技术优势减弱、市场竞争加剧、市场供求形势出现重大不利变化、采购成本持续提高或者出现产品销售价格持续下降等情况，将导致公司综合毛利率下降。

2、应收账款回收风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 6,903.92 万元、5,620.98 万元和 10,588.73 万元，占营业收入的比例分别为 13.70%、7.85%和 13.71%。虽然报告期各期末公司应收账款账龄结构良好，一年以内账龄的应收账款占比超过 99%，与同行业可比上市公司相比，公司应收账款占营业收入比例较低、应收账款周转率较高，发生坏账损失的风险较小，且公司已制订合理的坏账计提政策并有效执行，但若公司下游客户经营不利或由于其他原因导致无法按期支付货款，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的风险。

3、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货净额分别为 5,321.47 万元、11,124.82 万元和 13,703.00 万元，占总资产的比例分别为 11.53%、18.02%和 16.96%。随着公司业务规模的扩大，存货余额也会进一步上升。公司产品技术更新换代速度较快，如果未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，将增加计提存货跌价准备的风险，对公司经营业绩及经营现金流产生不利影响。

4、所得税优惠政策变动的风险

公司于 2017 年 11 月 17 日通过了高新技术企业复审，取得了《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732001619）。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，报告期内企业所得税实际执行税率为 15%。虽然国家税收优惠政策具备持续性，但未来如果上述税收优惠政策发生变化，或者本公司不再具备享受相应税收优惠的资质，则将对公司的经营业绩带来较大的不利影响。

(五)募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金投资项目主要包括“超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化”、“半导体功率器件封装测试生产线建设”、“碳化硅宽禁带半导体功率器件研发及产业化”和“研发中心建设”等。本次募集资金投资项目以国家产业政策为基础，充分把握半导体分立器件行业发展趋势而确定。上述募投项目的实施，有利于公司把握行业发展趋势，进一步巩固公司现有业务和培育新的业绩增长点，有效提升公司的技术研发实力和市场竞争力。但是，本次募投项目的实施，公司仍然面临来自市场变化、技术替代、宏观经济波动、募投项目管理等多方面的挑战和不确定性，因此公司存在无法如期完成募投项目或者项目投资收益不达预期的风险。

2、新增折旧摊销费用影响业绩的风险

公司的固定资产和无形资产整体规模较小。本次募投项目计划新增设备投入和生产场地投入，未来将引致公司资产总额增长幅度较高。随着新增固定资产和无形资产规模的扩大，募投项目投产后，资产折旧摊销会出现较快增长。尽管公司募投项目新增销售收入及利润总额较高，足以抵消募投项目新增的投资项目折旧摊销费用，但如果市场环境发生重大不利变化，公司现有业务及募投项目产生的收入及利润水平未实现既定目标，本次募投项目将存在因资产增加而引致的折旧摊销费用影响未来经营业绩的风险。

(六)其他风险

1、关联交易风险

报告期内，公司存在向关联方采购封测服务或销售产品的情形。针对上述关联交易，第一，公司制定了《关联交易决策制度》，对公司关联交易定价机制、审批决策程序等予以规范，并要求公司严格执行；第二，公司积极扩大采购渠道，加大销售力度，逐步减少与关联方之间的采购与销售占比；第三，公司控股股东、实际控制人、主要股东及公司董事、监事、高级管理人员签署减少和规范关联交易的相关承诺。虽然公司与关联方之间的关联购销主要系受到行业特点、技术要求、产品质量控制等因素影响而采取的自发市场行为，交易具有其合理性、公允性，交易占比逐年下降，但如果未来公司关联购销定价不公允，可能对公司和股东的经济利益产生不利影响。

2、成长性风险

公司的主营业务为 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售。随着半导体功率器件下游需求的迅猛增长以及公司产品技术实力不断提升，公司经营规模迅速扩大。报告期内，公司营业收入分别为 50,375.98 万元、71,579.03 万元和 77,253.69 万元，2018 年和 2019 年分别同比增长 42.09%和 7.93%。近年来国内半导体分立器件行业不断发展，国际巨头不断涌入，国内新进入者不断增多，行业竞争日趋激烈。未来公司能否保持持续、快速的增长，仍然受制于产业政策支持、宏观经济发展、下游行业增长、公司技术实力提升以及经营管理完善等多方面因素，因此，公司未来的经营业绩可能面临成长性风险。

3、摊薄即期回报风险

报告期内，公司扣除非经常性损益后的每股收益分别为 0.98、1.84 和 1.15，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 26.04%、33.28%和 16.77%。本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，通过本次募集资金提升公司研发实力、资金实力，其综合经济效益的产生需要一定的时间，投资项目回报的实现需要一定周期。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于总股本和净资产的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

二、其他重要事项

截至 2019 年 12 月 31 日，公司正在履行的重大商务合同如下：

(一)重要合同

1、重大销售合同

报告期内，公司与部分长期合作、采购量大、采购频繁的客户签订销售框架合同，日常销售以订单为交易依据。截至 2019 年 12 月 31 日，公司正在履行的对生产经营活动有重大影响的主要销售框架合同如下：

序号	合同相对方	合同编号	合同期限	合同标的
1	常州力森电子有限公司	NCEGXHT229	2018.01.01-2019.12.31	产品型号、数量等均以订单为准
2	星恒电源股份有限公司	NCEGXHT224	2018.01.01-2019.12.31	产品型号、数量等均以订单为准
3	苏州工业园区东南科技有限公司	NCEGXHT170-1	2019.12.23-长期	产品型号、数量等均以订单为准
4	无锡市晶汇电子有限公司	NCEGXHT254	2018.12.30-2020.12.29	产品型号、数量等均以订单为准
5	上海晶丰明源半导体股份有限公司	NCEGXHT122	2017.09.19-2020.09.18	产品型号、数量等均以订单为准
6	深圳市高斯宝电气技术有限公司	HR-PU-HP10-08A2	2017.07.31-长期	产品型号、数量等均以订单为准
7	广东科通电子实业有限公司	NCEGXHT195	2018.01.01-2019.12.31	产品型号、数量等均以订单为准
8	南京江智科技有限公司	NCEGXHT236	2018.01.01-2019.12.31	产品型号、数量等均以订单为准
9	杰华特微电子（杭州）有限公司	NCEGXHT121	2019.08.01-长期	产品型号、数量等均以订单为准
10	昆山九通电子有限公司	NCEGXHT251	2018.12.30-2020.12.29	产品型号、数量等均以订单为准
11	揭阳市中晶电子科技有限公司	NCEGXHT233	2018.01.01-2019.12.31	产品型号、数量等均以订单为准
12	无锡川本飞龙电子科技有限公司	080201	2016.08.02-2026.08.01	产品型号、数量等均以订单为准
13	常州市易尔通电子有限公司	NCEGXHT253	2018.12.30-2020.12.29	产品型号、数量等均以订单为准
14	昂宝电子（上海）有限公司	NCEGXHT208	2018.01.01-2019.12.31	产品型号、数量等均以订单为准
15	深圳市润得源电子有限公司	NCEGXHT110-1	2019.06.10-长期	产品型号、数量等均以订单为准
16	深圳市粤嘉鸿电子有限公司	NCEGXHT150	2019.07.20-长期	产品型号、数量等均以订单为准
17	东莞市盛锋电子有限公司	NCEGXHT162	2017.08.25-2020.08.24	产品型号、数量等均以订单为准
18	深圳市嘉龙腾电子有限公司	NCEGXHT211	2018.07.16-2020.07.15	产品型号、数量等均以订单为准
19	安徽省东科半导体有限公司	NCEGXHT212-1	2019.11.10-长期	产品型号、数量等均以订单为准
20	南京高上美电子有限公司	NCEGXHT277	2019.05.07-2021.05.06	产品型号、数量等均以订单为准
21	广州视琨电子科技有限公司	114-SK	2018.09.01-长期	产品型号、数量等均以订单为准
22	深圳市金誉半导体股份有限公司	NCEGXHT112-2	2018.07.01-2020.06.30	产品型号、数量等均以订单为准

2、重大采购合同

公司